Н. С. Казак¹, Г. В. Кулак², П. И. Ропот¹, О. В. Шакин³
¹Институт физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь
²УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Мозырь Беларусь
³Государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург, Россия

ШИРОКОПОЛОСНАЯ ДИФРАКЦИЯ СВЕТА НА ОБЪЕМНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ В ТРИГОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ

Введение

Дифракция света на УЗ волнах с возможностью частотной перестройки в широком диапазоне находит многочисленные применения при создании различных АО устройств обработки информации: широкополосных АО дефлекторов и модуляторов, спектроанализаторов, корреляторов, демодуляторов частотно- и фазомодулированных сигналов [<u>1</u>, <u>2</u>]. При этом важно знать форму амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в широком частотном диапазоне [<u>3</u>].

Результаты теоретических исследований

Пусть в периоде d многоэлементной системы ВШП сочетаются металлическая полоска шириной b и неметаллический участок шириной a (рисунок 1).

Подавая противофазное высокочастотное напряжение на электроды, можно возбудить объемные УЗ волны высокой частоты, распространяющиеся под малыми углами к оси *OZ*.

Расчет нормированной эффективности дифракции $\eta_n = \eta_s / \eta_{s \max}$ производился для YZ- среза кристалла ниобата лития (LiNbO₃) в условиях изотропной дифракции обыкновенных световых волн, поляризованных перпендикулярно плоскости дифракции, на сдвиговых УЗ волнах. Центральная частота рассчитывалась по формуле $f_0 = v_s (n/\lambda_0 d)^{1/2}$. С учётом [3] интенсивность УЗ волны для YZ-

среза кристалла $LiNbO_3$ определялась нами по формуле $I_a = (u_o^2 N f_o / A d v_s 10^5)$, где A = 8,6.



Рисунок 1 – Схема брэгговской АО дифракции (ВШП – встречно-штыревой преобразователь, Пг – поглотитель, ЛГ – лазерный генератор, АОП – антиотражающее покрытие)

Численные расчеты производились для одноосных кристаллов *LiNbO*₃ *YZ*-среза в условиях изотропной АО дифракции обыкновенных световых волн на сдвиговых УЗ волнах.

На рисунке 2 представлена зависимость η_n от приведенной частоты УЗ волны $F = (f - f_0)/f_0$. Из рисунка 2, видим, что, если центральная частота $f_0 = 1,75$ ГГц и числе пар электродов N = 40, ширина полосы АО взаимодействия составляет $\Delta f = 525$ МГц.



Рисунок 2 – Зависимость нормированной эффективности дифракции η_n от приведенной частоты ультразвука *F* (*d* = 15,2 мкм, λ_0 = 0,63 мкм, *N* = 40, $n = 2,3; p_{9\phi} = p_{14} = 0,07; I_a = 10 \text{ BT/cm}^2, \varphi_0 = 0,076 \text{ рад (4,35 град)},$ $\eta_{\text{max}} = 0,02, f_0 = 1,75 \Gamma\Gamma\mu; 1 - \theta_0 = -2; 2 - \theta_0 = -2 - 0.89/[Q(1+F)];$ 3 – в условиях изотропной дифракции)

Результаты экспериментальных исследований

Схема экспериментальной установки, предназначенной для наблюдения в кристалле *LiNbO*₃ брэгговской АО дифракции с поверхностным возбуждением УЗ волн, представлена на рисунке 3.



На рисунке 4 изображена амплитудно-частотная характеристика АО модулятора-дефлектора на основе кристалла *LiNbO*₃ с характеристиками, соответствующими приведённым на рисунке 2.



Рисунок 4 – Амплитудно-частотная характеристика АО модулятора-дефлектора (вдоль оси ординат отложены значения амплитуды, отсчитанные по шкале осциллографа; $f_0 = 1,75$ ГГц, $\lambda_0 = 0,63$ мкм, $LiNbO_3$)

Из рисунка 2 и рисунка 4 следует удовлетворительное соответствие результатов теоретических расчётов с экспериментальными.

Зависимость нормированной эффективности дифракции η_n от приведенной частоты *F* УЗ волны при разных значениях параметра Δn изображена на рисунке 5. Анализируя представленную на нём информацию, видим, что даже в условиях точного брэгговского синхронизма ($\theta_0 = -2$) АЧХ дефлектора может иметь широкий диапазон перестройки и приобретает форму двугорбой кривой с провалом в центре. При $\Delta n = 0,023$ ширина полосы частотной перестройки дефлектора составляет $\Delta f = 700$ МГц.



Рисунок 5 – Зависимость нормированной эффективности дифракции η_n от приведенной частоты ультразвука *F* при $\theta_0 = -2$ в условиях анизотропной дифракции при разной степени анизотропии (d = 15,2 мкм, $\lambda_0 = 0,63$ мкм, N = 40, n = 2,3; $p_{3\phi} = p_{14} = 0,07$; $I_a = 10$ BT/см², $\varphi_0 = 0,076$ рад (4,35 град), $\eta_{max} = 0,02$, $f_0 = 1,75$ ГГц; $1 - \Delta n = 0$; $2 - \Delta n = 0,01$; $3 - \Delta n = 0,023$)

Заключение

Таким образом, показано, что в тригональных кристаллах ниобата лития достижима ширина полосы пропускания АО модуляторадефлектора ~500 МГц; при учете электрооптического эффекта ширина полосы пропускания составляет ~700 МГц. АЧХ акустооптического модулятора-дефлектора со сканирующей диаграммой в условиях электроиндуцированной анизотропии существенно отличается от АЧХ устройства в ее отсутствие.

Литература

1. Белый, В. Н. Широкополосный акустооптический дефлектор на объемных акустических волнах / В. Н. Белый, И. Г. Войтенко, Г. В. Кулак // Журнал технической физики. – 1989. – Т. 59, вып. 5. – С. 82–85.

2. Волик, Д. П. Анализ амплитудно-частотной характеристики акустооптического дефлектора с поверхностным аподизированным

пьезопреобразователем // Д. П. Волик, В. В. Роздобудько // Журнал технической физики. – 2009. – Т. 79, № 6. – С. 124–128.

3. Балакший, В. И. Физические основы Сакустооптики / В. И. Балакший, В. Н. Парыгин, Л. Е. Чирково М.: Радио и связь, 1985. – 280 с.

4. Pelipenko, M. I. Optimization of parameters small aperture acoustmoptical deflectors / M. I. Pelipenko // Wave Electronics and Its Applications in the Information and Telecommunication Systems: VII International Conference for Young Researchers, St. Petersburg, Russia, 12–15 September 2004. – Saint-Petersburg: State University for Aerospace Instrumentation, 2004. – P. 29–30,

5. Дьельсан, Э. Упругие волны в твердых телах. Применение для обработки сигналов / Э. Дьельсан, Д. Руайе. – М.: Наука, 1982. – 424 с.

6. Хаус, Х. Волны и поля в оптоэлектронике / Х. Хаус. – М.: Мир, 1988. – 430 с.

7. Яковкин, И. Б. Дифракция света на акустических поверхностных волнах / И. Б. Яковкин, Д. В. Петров. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1979. – 184 с.